

# SOT223 NPN SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR

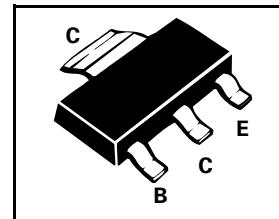
FZT649

ISSUE 4- FEBRUARY 1996

## FEATURES

- \* 25 Volt  $V_{CEO}$
- \* 3 Amp continuous current
- \* Low saturation voltage
- \* Excellent  $h_{FE}$  specified up to 6A

COMPLEMENTARY TYPE – FZT749



PARTMARKING DETAIL – FZT649

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	35	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	25	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	8	A
Continuous Collector Current	$I_C$	3	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ C$	$P_{tot}$	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_J; T_{stg}$	-55 to +150	°C

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

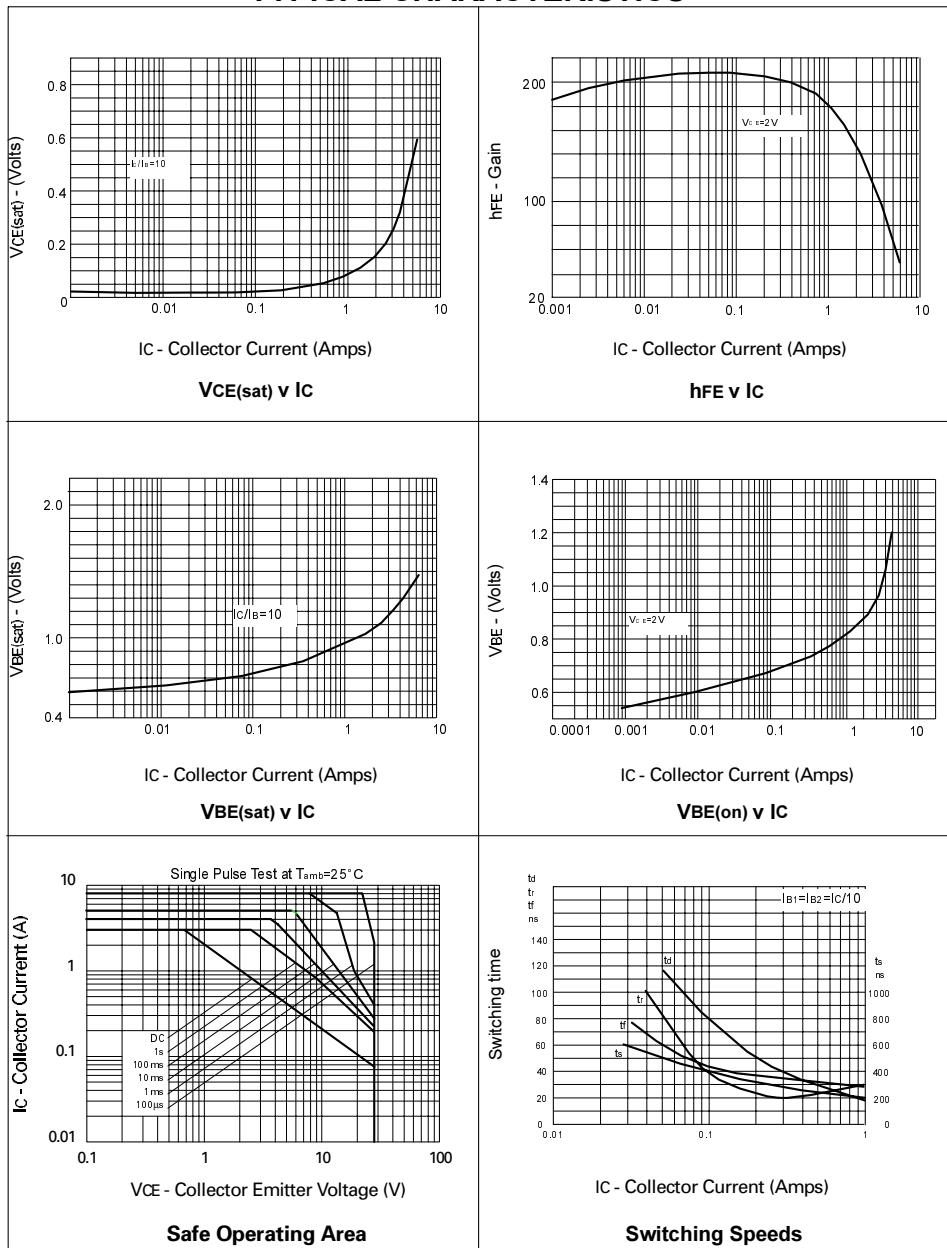
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	35			V	$I_C=100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	25			V	$I_C=10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu A$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			0.1 10	$\mu A$	$V_{CB}=30V$ $V_{CB}=30V, T_{amb}=100^\circ C$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			0.1	$\mu A$	$V_{EB}=4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.12 0.40	0.3 0.6	V	$I_C=1A, I_B=100mA^*$ $I_C=3A, I_B=300mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.9	1.25	V	$I_C=1A, I_B=100mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.8	1.0	V	$I_C=1A, V_{CE}=2V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	70 100 75 15	200 200 150 50	300		$I_C=50mA, V_{CE}=2V^*$ $I_C=1A, V_{CE}=2V^*$ $I_C=2A, V_{CE}=2V^*$ $I_C=6A, V_{CE}=2V^*$
Transition Frequency	$f_T$	150	240		MHz	$I_C=100mA, V_{CE}=5V$ $f=100MHz$
Output Capacitance	$C_{obo}$		25	50	pF	$V_{CB}=10V, f=1MHz$
Switching Times	$t_{on}$		55		ns	$I_C=500mA, V_{CC}=10V$
	$t_{off}$		300		ns	$I_{B1}=I_{B2}=50mA$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300μs. Duty cycle ≤2%

Spice parameter data is available upon request for this device

# FZT649

## TYPICAL CHARACTERISTICS





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331